04

О предельном токе разряда электродугового плазмотрона постоянного тока с трубчатыми электродами

© В.М. Кулыгин, А.В. Переславцев, С.С. Тресвятский

Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", 123182 Москва, Россия e-mail: Kulygin_VM@nrcki.ru

(Поступило в Редакцию 24 июня 2017 г.)

Имеющиеся в литературе сведения о наличии предельного тока на катодную вставку плазмотрона и связи его величины с диаметром этой вставки обсуждены на основе предположения о том, что это соответствие связано с достижением критической температуры поверхности вставки, при которой происходит резкое увеличение скорости испарения материала.

DOI: 10.21883/JTF.2018.03.45591.2404

Введение

Экспериментальные данные, получаемые при работе с плазмотронами, обычно носят интегральный характер, поэтому суждения о деталях механизма рабочего процесса можно делать лишь косвенно, привлекая модельные физические соображения и сопоставляя полученные результаты с результатами измерений. В настоящей работе мы воспользуемся таким подходом для анализа прикатодных процессов в электродуговом плазмотроне постоянного тока.

В работе [1] устанавливается соответствие между диаметром используемой катодной вставки и предельным током дуги плазмотрона. В табл. 1 приведены соответствующие цифровые данные. Превышение указанных предельных значений ведет к резкому уменьшению срока службы катодной вставки

Имея в виду этот результат, обсудим возможный механизм, обусловливающий существование такого порога. Ранее [2] было установлено, что скорость испарения гафниевой вставки, определяющая ресурс ее работы, существенно меньше скорости испарения чистого гафния в вакуум. Было сделано предположение о возможности влияния на замедление процесса испарения материала вставки двух факторов:

• наличия вблизи ее поверхности давления рабочего газа,

• наличия на этой поверхности пленки оксида и нитрида гафния.

Пороговый характер обсуждаемого явления позволяет предположить, что упомянутый предел определяется достижением некоторого критического значения температуры поверхности, при котором происходит резкое увеличение скорости испарения материала катодной

Таблица 1	
-----------	--

Диаметр вставки, ст	0.16	0.2	0.25	0.30
Предельный ток дуги, А	80	200	300	400

вставки. Логично поэтому принять в качестве рабочей гипотезы определяющее действие второго из названных факторов ограничения испарения: наличием оксиднонитридной корки на поверхности расплавленного слоя материала, а критической температурой счесть температуру плавления этой корки (наиболее тугоплавкой — нитридной, 3063 K).

Рабочая модель и результаты расчета

Прикатодную область дуги плазмотрона можно условно разделить на три части.

• Поверхность катодной вставки, нагрев которой производится потоком падающих (и рекомбинирующих) ионов и излучением из дуговой плазмы, а отвод тепла в основном эмиссией электронов и теплопроводностью, так как испарение материала и тепловое излучение дают незначительный вклад. (В азоте воздуха при атмосферном давлении потери на излучение составляют одиннесколько процентов от вкладываемой мощности.)

• Прикатодный слой, примыкающий непосредственно к катоду; в нем сильное электрическое поле ускоряет электроны, эмитированные катодом, и ионы, падающие на катод. Его толщина должна значительно превышать дебаевский радиус плазмы предслоя и быть меньше пробега электронов и ионов до столкновения с атомами газа.

• Предслой — переходная часть дугового столба, в которой происходит торможение плазменных электронов и предускорение ионов. Толщина этой части прикатодной области определяется длиной пробега катодного электрона до термализации за счет столкновений с молекулами (атомами) газа.

Прикатодный слой можно рассматривать как плоский диод, причем, хотя там происходит ускорение и ионов и электронов (в противоположных направлениях), объемный заряд в нем определяется ионами из-за их значительно большей массы. Поэтому, пренебрегая вкладом электронов, мы можем использовать закон 3/2 для определения плотности ионного тока, стабильно ускоряемого в слое:

$$j_i = \frac{5.4 \cdot 10^{-8}}{\sqrt{\mu_i}} \cdot \frac{U^3/2}{d^2}.$$
 (1)

Здесь j_i — плотность ионного тока, A/cm²; U — напряжение на слое, V; d — толщина слоя, cm; μ_i — масса иона в отношении к протонной массе.

Такая плотность ионного тока должна обеспечиваться поступлением на границу слоя со стороны плазмы предслоя потока ионов со скоростью, определяемой температурой этой слабоионизованной плазмы, которая изза высокой частоты столкновений с газовыми атомами практически одинакова для всех компонентов и равна температуре газа [3]:

$$j_i = 0.96 \cdot 10^{-13} \cdot n_i \sqrt{\frac{2 \cdot T_p}{\mu_i}},$$
 (2)

где n_i — концентрация ионов в предслое, ст⁻³; $T_p = \frac{T_g}{1.16 \cdot 10^4}$ — температура плазмы, eV; T_g — температура газа, K; μ_i — массовое число иона. Размер дебаевского радиуса оценивается по формуле

$$\lambda_D = 7.43 \cdot 10^2 \cdot \sqrt{\frac{T_p}{n_e}}, \quad \text{cm} \tag{3}$$

Концентрация электронов $n_e = n_i$ — из условия квазинейтральности плазмы, так как ионы при интересующих нас температурах будут однозарядными. Ионизация в разрядном столбе происходит термическим путем независимо от того, каким путем энергия в него вкладывается, поэтому плотность ионов в предслое можно оценить с помощью формулы Саха

$$n_i \approx \sqrt{n_a \cdot 3 \cdot 10^{21} \cdot T_g^{1.5} \cdot \exp(-\frac{11600 \cdot \Phi_N}{T_g})}, \ \mathrm{cm}^{-3}, \ (4)$$

где $\Phi_N = 14.5 \,\text{eV}$ — энергия ионизации азота, n_a — концентрация атомов азота. Дополним набор формул (1)-(4) выражением для оценки длины свободного пробега для атомов (ионов) азота

$$\lambda_{free} = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot n_a \cdot \pi \cdot a_N^2 \cdot \left(1 + \frac{C_N}{T_g}\right)}, \quad \text{cm}, \qquad (5)$$

где a_N — радиус атома азота, $C_N \approx 120$ — поправочная постоянная для азота. После чего, определив плотность потока рабочего газа в канале плазмотрона

$$q_g = \frac{Q_g}{S_c}, \qquad \mathrm{g/(s \cdot cm^2)}, \qquad (6)$$

где Q_g — расход рабочего газа в единицу времени, S_c — площадь сечения канала, и тепловую скорость газа в канале

$$v_g = 9.28 \cdot 10^3 \cdot \sqrt{\frac{T_g}{\mu_N}}, \quad \text{cm/s}, \tag{7}$$



Зависимость характерных размеров: I — ширина слоя в соответствии с "законом 3/2", 2 — радиус Дебая, 3 — длина пробега иона в газе от температуры газа в предслое. Оценка проведена для удельного расхода воздуха (азота) $q_g \approx 1 \text{ g/(cm^2s)}$ в плазмотроне ЭДП-200 [2].

оценим пролетную плотность атомов газа

$$n_a = \frac{q_g}{v_g \cdot m_N}, \quad \text{cm}^{-3}, \tag{8}$$

где *m_N* — масса атома азота, g.

Затем, приняв напряжение на прикатодном слое равным 10 V и варьируя температуру газа, оценим с помощью выражений (1)-(5) соотношение между тремя интересующими нас характерными размерами. Результат представлен на рисунке, из которого видно, что требуемое соотношение между шириной прикатодного слоя, дебаевским радиусом и длиной свободного пробега иона до столкновения с атомом газа выполнено в интересующем нас диапазоне температур газа в предслое.

Далее считаем, что резкое увеличение испарения материала катодной вставки наступает при достижении ее поверхностью температуры плавления нитридной корки: $T_c = 3060$ K.

Плотность тока эмиссии электронов при этой температуре с учетом эффекта Шоттки выражается следующей формулой [2]:

$$j_{ec} = A \cdot T_c^2 \cdot \exp\left[-\frac{\Phi_{ex} - e^{1.5} \cdot \sqrt{E_c/300 \cdot 6.24 \cdot 10^{11}}}{T_c/11600}\right],\tag{9}$$

 $A(A/K^2) = 129.4, \Phi_{ex} (eV)$ — работа выхода электронов из катода, для гафния: $\Phi_{ex} = 3.53 eV, e$ — заряд электрона (ед. СГСЭ), $E_c = U/d$ — напряженность электрического поля у катода (V/cm).

Дополнив формулы (1), (2), (4), (6)–(9) выражением для тока разряда $I_d = (j_{ec} + j_i) \cdot S_c$, где $S_c = \pi \cdot d^2/4$ — площадь катодной вставки, и соотношением $\eta = j_i/(j_{ec} + j_i)$ — доля ионного тока в токе разряда, и используя в качестве варьируемых параметров U, T_g и q_g , получим систему, связывающую предельный ток разряда с диаметром вставки и значениями параметров,

Tuomiqu 2.						
Диаметр вставки, d, cm	0.16	0.2	0.25	0.3		
Предельный ток дуги, Icr, А	80.85	198.50	306.32	402.88		
Катодное падение потенциала, U _K , B	25	7.6	6.7	5.61		
Толщина катодного слоя, $\lambda_{\rm K}, \ 10^{-5} {\rm cm}$	8.667	1.462	1.109	1.051		
Концентрация атомов газа, $10^{16} \mathrm{cm}^{-3}$	9.611	13.14	13.14	13.25		
Температура газа, К	10300	12400	12400	12200		
Доля ионнго тока	0.06	0.224	0.227	0.219		

Таблица 2.

сопутствующих анонсированной критической эффективной температуре эмиссионной поверхности катодной вставки. Результаты решения этой системы представлены в табл. 2.

Обсуждение результатов и выводы

Сравнение значений диаметра вставки и соответствующих ему расчетных значений критического тока с соответствующими данными табл. 1 дает основание считать, что принятая для расчета модель достаточно хорошо описывает наблюдаемое экспериментально явление резкой потери ресурсной способности вставки. Результаты косвенно подтверждают объяснение понижения скорости испарения материала гафниевой вставки в азотнокислородной среде образованием нитридной/оксидной корки на поверхности вставки.

Список литературы

- Аньшаков А.С., Бутова М.Н. и др. // Тр. V Всесоюз. конф. по генераторам низкотемпературной плазмы. Новосибирск: Институт теплофизики СО АН СССР, 1972. Т. 2. С. 48–52.
- [2] Гнеденко В.Г., Иванов А.А., Переславцев А.В., Тресвятский С.С. // Вопросы атомной науки и техники. Серия: Плазменная электроника и новые методы ускорения. 2006. № 5. С. 75–79.